**doi**:10.3788/gzxb20124110.1247

# 不同氧气流量对直流磁控溅射 TiO<sub>2</sub> 薄膜的影响

## 樊晓娟,赖珍荃,李睿

(南昌大学物理系,南昌 330031)

摘 要:采用直流反应磁控溅射法,以高纯 Ti 为靶材,高纯 O<sub>2</sub> 为反应气体,制备了 TiO<sub>2</sub> 薄膜.研 究了氧气流量对薄膜结晶取向、表面形貌和光学性能的影响.研究发现,TiO<sub>2</sub> 薄膜主要呈锐钛矿 TiO<sub>2</sub>(101)择优取向,当氧气流量较小时,薄膜中还含有金属 Ti(100),氧气流量较大时,薄膜含 TiO<sub>2</sub>(101)和 TiO<sub>2</sub>(004),成多晶态;薄膜的粗糙度和颗粒大小都随氧气流量的增大而增大;薄膜在 400~1 100 nm 可见-近红外波段有较高的透射率并且其吸收峰随着氧气流量的增大而红移,当氧 气流量为 5 sccm 时,平均透射率最高.

关键词:TiO2 薄膜;直流磁控溅射;氧气流量;透射率

**中图分类号:**O469 文献标识码:A

0 引言

TiO<sub>2</sub> 薄膜具有优异的物理和化学性质,正受到 越来越多的关注.它因其催化活性高、对人体无毒 害、不发生光腐蚀、有很强的氧化性和还原性而被广 泛应用在光催化领域<sup>[1-3]</sup>.另外它在400~1100 nm 可见-近红外光区具有高透射率和2.2~2.7的高折 射率,而在红外波段具有高的反射率,是一种非常重 要的光学薄膜,正在被越来越多的应用在减反射薄 膜、干涉滤波片和薄膜光波导<sup>[4-6]</sup>等领域,特别是近 些年来它作为一种最有前景的硅太阳能电池减反 膜<sup>[7]</sup>,对太阳能光电转换效率的提高起着至关重要 的作用.

制备 TiO<sub>2</sub> 薄膜的方法很多,有化学气相沉积 法、溶胶-凝胶法、电子束激发沉积法、分子束外延 法、磁控溅射法等.目前国内研究多采用溶胶-凝胶 法<sup>[8]</sup>,它操作工艺简单易行,但制备出来的薄膜不够 均匀致密、附着力差、膜层易脱落,而用磁控溅射 法<sup>[9]</sup>制备的薄膜可以解决这些问题,并且它的沉积 速率高、膜厚可控、装置性能稳定、可以大面积生产, 因此在减反射薄膜、多层光学薄膜、光波导等方面的 应用有着明显的优势.

在磁控溅射法制备薄膜的工艺中,基底温度、溅 射电流、溅射气压和反应气体比例等都对薄膜性能 有很大影响.本文利用直流(Direct Current,DC)磁 控溅射法制备薄膜,在不同氧气流量的情况下对薄 **文章编号:**1004-4213(2012)10-1247-4 膜进行了分析.

### 1 实验

#### 1.1 实验方法

用 CKJ-500D 型多 靶磁 控溅射 镀膜机制备 TiO<sub>2</sub> 薄膜样品.实验以高纯钛靶(99.995%)为溅射 靶材,高纯 Ar 和 O<sub>2</sub>(纯度均为 99.999%)分别为溅 射气体和反应气体,单面抛光 Si(p-111)片和载玻片 (用以测试透射率)为衬底.先后用氢氟酸(载玻片除 外)、丙酮、无水乙醇、去离子水将衬底在超声波清洗 机中各清洗 8 min,烘干后快速放入真空腔中,用机 械泵 分子泵 抽 真空 2 h,当腔体气压达到极限 5.0×10<sup>-4</sup> Pa后,先通 Ar 预溅射 30 min 以除去靶 表面氧化物(辉光从粉红变成淡蓝色说明氧化物已 去除),之后再通入氧气正式溅射,具体工艺参量如 表 1.

表 1	DC	磁控测	<b>刬射法</b>	沉积	TiO <sub>2</sub>	薄膜的	的基本	:エ艺	参量
Tał	ole 1	The	craft (	of Ti	O <sub>2</sub> thi	n film	is depo	osited	by
DC snuttering									

De spattering					
Craft of DC sputtering	Parameters				
Substrate-target distance/mm	80				
Deposition time/h	1				
Substrate temperature/( $^\circ\!\mathrm{C}$ )	500				
Argon gas flow/sccm	30				
Sputtering current/A	0.5				
Sputtering pressure/Pa	0.6				

通过只改变氧气流量,分别为 2、5、10、 15 sccm,得到不同条件下的 TiO<sub>2</sub> 薄膜. 薄膜沉积

基金项目:中国科学院红外物理重点实验室开放基金(No. 201005)和江西省教育厅科技项目(No. GJJ10380)资助 第一作者:樊晓娟(1986-),女,硕士研究生,主要研究方向为光伏物理. Email:muxiaojuanjuan@126.com 导师(通讯作者):赖珍荃(1963-),男,教授,主要研究方向为光电功能材料. Email:zqlai@ncu. edu. cn 收稿日期: 2012-06-12;修回日期:2012-07-06

# 11 守逊

后,在各个工艺参量下各选一块放入马弗炉中 500° 下退火两小时以便测定其 X 射线衍射(X-Ray Diffraction, XRD).

## 1.2 测试方法

采用 Bede-D1 型 X 射线衍射仪对样品进行物 相分析,其X射线衍射源为 CuKa( $\lambda$ =0.154 056 nm), 电流为 40 mA,加速电压为 40 kV,扫描方式为 $\theta/2\theta$ 的步进扫 0.02°,扫描范围(10~80)°,停留时间 0.1 s/step.采用上海爱建纳米 AJ-III 型原子力显微镜 (Atomic Force Microscope, AFM)在1000×1000 nm<sup>2</sup> 范围内扫描薄膜表面形貌,分析其颗粒尺寸、表面粗 糙度.用 UV762 型双光束紫外-可见分光光度计测 定波长范围为 200~1 100 nm 的透射率.

## 2 实验结果与讨论

### 2.1 薄膜晶向分析

图 1 是氩气流量为 30 sccm,氧气流量分别为 2、5、10、15 sccm 的情况下在单晶硅上生长的 TiO<sub>2</sub> 薄膜经 500°退火两小时后的 XRD 图.

从图中可以看出,所有样品都在  $2\theta=28.4^{\circ}$ 出现 了 Si(111)衍射峰和在  $2\theta=25.3^{\circ}$ 出现了锐钛矿相 TiO<sub>2</sub>(101)衍射峰,出现 Si(111)衍射峰的原因是 X 射线的穿透能力强,以致于穿透了硅基底造成的.进





Fig. 1 The XRD pattern of TiO<sub>2</sub> thin films

一步发现在氧气流量较小仅为2 sccm 时,还在 2 $\theta$ = 35.1°出现了 Ti(100)衍射峰,这是因为氧气流量较 少,没有足够的氧与钛发生反应,薄膜处于氧控制阶 段,沉积速率较高,溅射能量也较大,Ar<sup>+</sup>轰击出来 的钛原子来不及与氧气发生反应就直接沉积在硅基 底上.随着氧气的增大,存在富足的氧与钛反应,使 得 TiO<sub>2</sub> 晶粒得以生长,TiO<sub>2</sub>(101)择优取向明显. 当氧气流量继续增大时,极易与靶材发生氧化反应, 从而在基底表面形成多晶态薄膜,并且在2 $\theta$ =37.8° 出现锐钛矿相 TiO<sub>2</sub>(004)衍射峰.

#### 2.2 表面形貌分析

图 2(a)~(d)分别为氩气流量为 30 sccm,氧气



图 2 TiO<sub>2</sub> 薄膜的 AFM 图 Fig. 2 The AFM pattern of TiO<sub>2</sub> thin film

流量为2、5、10、15 sccm的情况下在单晶硅上生长 的 TiO<sub>2</sub> 薄膜的 AFM 图. 通过软件分析(表 2)可 知:随着氧气与氮气流量比的增大,TiO2薄膜表面 形貌发生了明显变化,薄膜的表面粗糙度和颗粒大 小都随氧气浓度的增大而逐渐增大,当氧气流量为 2 sccm 时表面粗糙度最小为 9.393 nm, 而当氧气流 量为 15 sccm 时表面粗糙度最大为 22. 210 nm. 从 图中看出 TiO<sub>2</sub> 薄膜生长行为在氧气流量为 5 sccm 时出现转变,表明存在控制薄膜生长的临界 O2 分 压. 在 O<sub>2</sub> 分压达到临界值之前, Ti、O 化合过程中 Ti 过量,薄膜处于 O 控制生长阶段,而氧含量决定 着成膜速率,低氧条件下成膜速率较快,沉积离子没 有充足弛豫时间寻找低能位置,成核随机性大,导致 成核密度增加而晶粒尺寸较小. 而氧分压达到临界 值后,Ti、O化合过程中O过量,此时成膜空间中氩 气相对减少,溅射产率降低,Ti含量较低,成核的驱 动力较小,使得薄膜临界成核尺寸较大,但变化较

小,薄膜表面颗粒密度及尺寸基本处于稳定状态.当 氧气含量过高时,沉积速率较低,沉积离子有充足的 弛豫时间寻找低能位置,导致成核密度降低,晶粒尺 寸增加.这与文献[10]研究类似.

#### 表 2 不同氧气流量沉积的 TiO<sub>2</sub> 薄膜表面均方粗糙度 和颗粒大小

Table 2The mean square roughness and particle size ofTiO2thin films deposited in different O2flow rate

Sample	Oxyen gas	Mean square	Particle
No.	flow	roughness/(rms • $nm^{-1}$ )	$\rm size/nm$
А	2	9.393	30.653
В	5	19.025	87.162
С	10	19.395	90.013
D	15	22.210	102.801

#### 2.3 光学性能分析

透射率是薄膜光学性能的一个重要性能指标, 本文采用紫外分光计对玻璃基底上生长的 TiO<sub>2</sub> 薄 膜在 200~1 100 nm 范围进行了测试分析,其结果 如图 3 所示,其 a、b、c、d 分别为氧气流量是 2、5、 10、15 sccm 时的透射率.从图中可以看出,薄膜在 可见光波段有较强的透射率,并且透射率的大小与 氧气流量的多少有很大的关系.我们知道,电磁辐射 在界 面上的行为可以用麦克斯韦方程  $R = l - \sqrt{8\omega\epsilon_0/\sigma}$ 来描述,其中 R 为反射率, $\omega$  为电磁辐射圆 频率, $\epsilon_0$  为真空介电常量, $\sigma$  为材料电导率.可见,在 可见-近红外光区,反射率取决于薄膜电导率,电导 率越大,反射率越大,透射率越小.当氧气流量为 2 sccm时,薄膜中含有大量的钛原子,电导率大,因 此透射率较小,经分析可知薄膜在 400~1 100 nm 可见-近红外光区平均透射率仅为 43.76%,370 nm 处透射率最大为54.06%;当氧气流量增大时,有足够的氧与钛发生反应生成TiO<sub>2</sub>,电导率变小,透射率增强.分析发现,当氧气流量为5 sccm时,薄膜在400~1 100 nm可见-近红外光区平均透射率为77.02%,411 nm处为最大透射率86.71%;当氧气流量为10 sccm时,平均透射率为71.04%,423 nm平均透射率为71.50%,433 nm处为最大透射率89.44%.可见在氧气流量变大时存在临界值使薄膜透射率最大,并且发现吸收峰呈现红移趋势,这是由于氧气流量变大时,晶粒团簇变大,基于晶粒的尺寸效应,薄膜的禁带宽度随晶粒的增大而减小,致使吸收峰向长波方向移动,表现为红移<sup>[11]</sup>.另外发现在波长低于400 nm附近,透射率急剧下降,这是TiO<sub>2</sub> 在紫外波段的带间跃迁吸收而引起的.



Fig. 3 The transmittance of  $TiO_2$  thin films

## 3 结论

1)TiO<sub>2</sub> 薄膜主要呈锐钛矿 TiO<sub>2</sub>(101)择优取向,当氧气流量较小时,薄膜中含有金属 Ti,当氧气流量较大时,薄膜呈多晶态.

2)TiO<sub>2</sub> 薄膜表面的均方根粗糙度和颗粒大小 都随氧气流量的增大而增大,氧气流量为 5 sccm 是 生成光滑致密 TiO<sub>2</sub> 薄膜的临界值.

3)TiO<sub>2</sub> 薄膜在可见一近红外光区有很高的透 射率,当氧气流量较小时平均透射率仅有43.76%, 而随着氧气流量变大透射率则明显提高,并且吸收 峰红移,当氧气流量为5 sccm时,可见-近红外波段 平均透射率最高达77.02%.

#### 参考文献

- DUMITRIU D, BALLY A R, BALLIF C, et al. Photocatalytic degradation of phenol by TiO<sub>2</sub> thin films prepared by sputtring [J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2000, 25(25): 83-92.
- [2] HU An-ming, ZHANG Xu, PNEG Peng, et al. Hydrothermal growth of free standing TiO<sub>2</sub> nanowire membranes for photocatalytic degradation of pharmaceuticals
   [J]. Journal of Hazardous Materials, 2011, 189(1): 278-285.

胡安明,张旭,彭鹏,等.光催化降解制药独立的二氧化钛纳线 膜的水热法生长[J].有害物质,2011,**189**(1):278-285.

- [3] ZHENG Zi-yao, WANG Zhu, LI Chun-ling, et al. Magnetron sputtering deposition Low-E film and AFM analysis [J]. Semiconductor Optoelectronic, 2005, 26(5): 418.
  郑子尧, 王柱, 李春领,等. 磁控溅射法沉积低辐射膜及 AFM 分析[J]. 半导体光电, 2005, 26(5): 418.
- [4] HARIZANOVA A, KOUTZAROVA T. Preparation and characterization of ZnO-TiO<sub>2</sub> films obtained by sol-gel method
   [J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2011, 357 (15): 2840-2845.
- [5] MUN K S, ALVAREZ S D, CHOI W Y, et al. A stable, label-free optical interferometric biosensor based on TiO<sub>2</sub> nanotube arrays[J]. ACS Nano, 2010, 4(4): 2070-2076.
- [6] DHOLAM R, PATEL N, MIOTELLO A. Efficient H-2 production by watersplitting using indium-tin-oxide/V-doped TiO<sub>2</sub> multilayer thin film photocatalyst [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2011, 36(11): 6519-6528.
- [7] LI Li, ZHANG Gui-you, CHEN Ren-jie, et al. Dye-sensitized solar cell and TiO<sub>2</sub> thin film materials research progress[J]. Functional Materials, 2008, 11(39): 1765-1769.
   李丽,张贵友,陈人杰,等. 染料敏化太阳能电池及 TiO<sub>2</sub> 薄膜

材料研究进展[J]. 功能材料,2008,11(39): 1765-1769.

- [8] CHANTAL G, BERNARD B, CEDRIC D, et al. Physicochemical properties and photocatalytic antivities of TiO<sub>2</sub>-films prepared by sol-gel methods[J]. Applied Catalysis Environmental, 2002, 39(4): 331-342.
- [9] SHI Zhong-bing, TONG Hong-hui, ZHAO Jia-xue, et al. Optimized design of the magnetic field of magnetron sputtering rectangular target[J]. Vacuum and Cryogenics, 2004, 10(2): 112-116.

石中兵,童洪辉,赵嘉学,等.磁控溅射矩形靶磁场的优化设计 [J]. 真空与低温,2004,10(2):112-116.

[10] LANG Ming, JIANG Hong, XU Hong-wen, et al. Partial pressure of oxygen prepared by magnetron sputtering film and its photocatalytic performance[J]. Glass, 2004, 174(3): 6-9.

郎明,姜宏,徐鸿文,等. 氧分压对磁控溅射法制备薄膜及其光 催化性能的影响[J]. 玻璃,2004,**174**(3): 6-9.

[11] ZHENG SK, WANG T M, XIANG G, et al. Photocatalytic activity of nanostructured TiO<sub>2</sub> thin films prepared by DC magnetron sputtering method[J]. Vacuum, 2001, 62(4): 361-366.

# Influence of the Oxygen Flow on TiO<sub>2</sub> Thin Films Prepared by DC Magnetron Sputtering

FAN Xiao-juan, LAI Zhen-quan, LI Rui

(Department of Physics Nanchang University, Nanchang 330031, China)

Abstract:  $TiO_2$  thin films were prepared by DC reactive magnetron sputting using high putity Ti as the targets and high  $O_2$  as the reaction gas. The influence of the oxygen flow on the film crystalline orientation, surface morphology and optical properties were studied. The results show that the  $TiO_2$  films is anatase  $TiO_2$  (101) preferred orientation; when the oxygen flow rate is small, the film also contains metal Ti(100); when the oxygen flow was larger, the films containing  $TiO_2$  (101) and (004) into a polycrystalline state; the roughness and particle size of the films increases with oxygen flow; film visible-near-infrared bands have a higher transmission rate and the absorption peak increases with the oxygen flow in the  $400 \sim 1\ 100\ nm$  redshift; when oxygen flow 5 sccm, the average transmission is largest. Key words:  $TiO_2$  thin films; DC magnetron sputting; Oxygen flow; Thansmittance